

(19) 대한민국특허청(KR)  
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl. <sup>6</sup> H01L 21/283	(11) 공개번호 (43) 공개일자	특1990-0000989 1990년01월31일
(21) 출원번호	특1988-0008106	
(22) 출원일자	1988년06월30일	
(71) 출원인	주식회사 금성사      최근선 서울특별시 영등포구 여의도동 20번지	
(72) 발명자	이경일	
(74) 대리인	서울특별시 강동구 등촌동 주공아파트 318동 302호 남사준	

심사청구 : 없음

(54) 반도체 콘택트 제조방법

요약

내용 없음

대표도

도1

명세서

[발명의 명칭]

반도체 콘택트 제조방법

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명 방법의 공정도

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

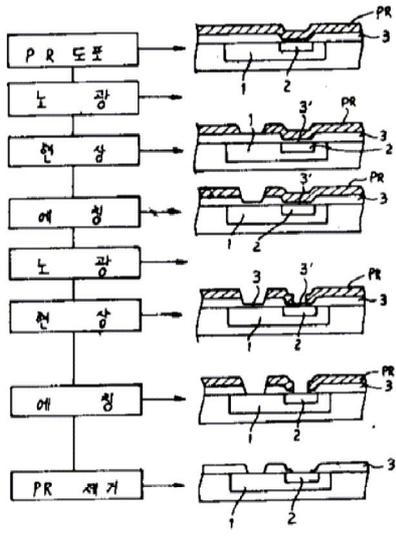
청구항 1

베이스 및 에미터 영역(1,2)위의 산화층(3)에 감광층(PR)을 도포하여 베이스 콘택트마스크로서 베이스 영역(1)위에만 노광 및 현상하여 베이스 영역(1)위의 산화층(3)을 노출시킨다음 베이스 영역 산화층(3)을 에미터 영역 산화층(3')의 두께만큼 에칭한후 다시 에미터영역(2)위의 감광층(PR)만 에미터 콘택트 마스크로서 노광 및 현상하여 에미터 영역(2)위의 산화층(3')을 노출시켜 산화층(3,3')을 동시에 에칭하여 베이스 및 에미터 영역을 노출시킨 다음 감광층(PR)을 제거하는 공정으로된 반도체 콘택트 제조방법.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

도면1



- 36 -